

П213Б

П А С П О Р Т

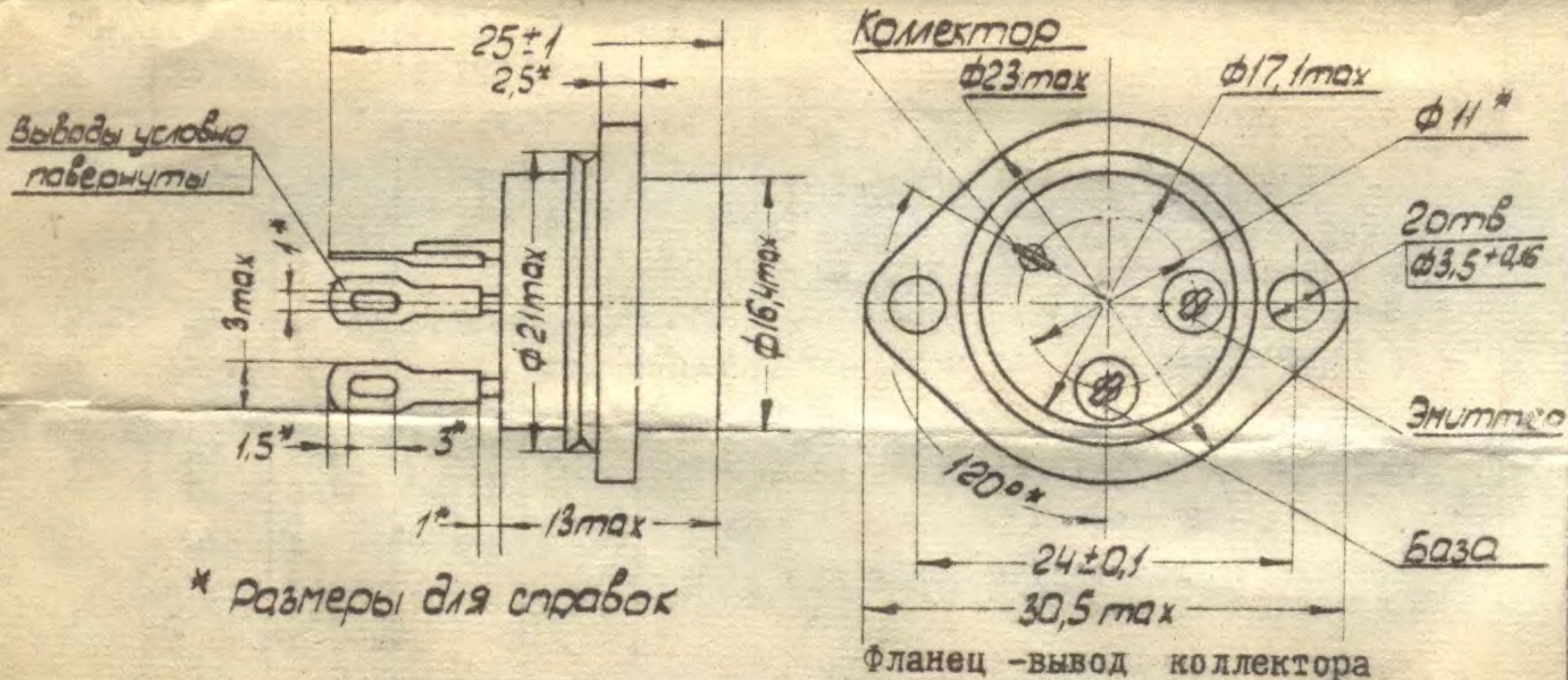
Транзисторы типа П213 ÷ П215
соответствуют частным техническим условиям:
З.365.012 ТУ ред. 3-69 и ОТУ 0.336.001 ред. 3-6



Партия приборов в количестве 50 штук

Предъявительское извещение № _____ от _____

Изготовление _____ И С П 172



* Размеры для справок

Вес - 17 г

В одном транзисторе содержится 1,8615 Мг серебра.

1. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ.

Т и п прибора	Наименование параметра			
	Коэффициент прямой передачи тока в режиме малого сигнала h_{21e} не менее	Крутизна передаточной характеристики $S_{пер}$ (А/В)	Обратный ток коллектора $I_{сво}$ при +20°C при $I_{св}$ max не более(мА)	Обратный ток эмиттера $I_{ев}$ при +20°C при $I_{ев}$ max не более(мА)
1	2	3	4	5
П213	20 + 50	-	0,15	0,3
П213А	20	-	1,0	0,4
П213Б	40	-	1,0	0,4
П214	20 + 60	-	0,3	0,3
П214А	50 + 150	-	0,3	0,3

11513E

1	2	3	4	5
П214Б	20 + 150	-	0,15	0,3
П214В	20	-	1,5	0,4
П214Г	-	1,4 + 2,1	1,5	0,4
П219	20 + 150		0,3	0,3

2. ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

наименование режима	допустимые значения режимов для:					
	П213	П213А П213Б	П214 П214А	П214Б	П214В П214Г	П215
1. Максимально-допустимое напряжение коллектор-база (ампл.) $U_{свm} max (v)$	-45	-45	-60	-60	-60	-80
2. Максимально-допустимое напряжение коллектор-эмиттер (ампл.) $U_{свm} max (v)$ при: а) $I_b = 0$ б) $R_{ев} \leq 50 \Omega$	-30 -40	- -30	-45 -55	-45 -55	- -55	-60 -70
3. Максимально-допустимое напряжение эмиттер-база (ампл. и постоянное) $U_{ев} max (v)$	-15	-10	-15	-15	-10	-15
4. Максимально-допустимый ток коллектора $I_c max (A)$	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5. Максимально-допустимый ток базы $I_b max (A)$	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Максимально-допустимая мощность, рассеиваемая транзистором $P_{сmax} (w)$ а) при температуре теплоотвода до + 45°C б) при температуре теплоотвода свыше + 45°C	11,5	10	10	11,5	10	10
7. Максимальная температура перехода $t_j max (°C)$	+85	+85	+85	+85	+85	+85

$$P_{с max} = \frac{+85^{\circ}C - t^{\circ}_{case}}{R_{thjc}}$$

3. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТРАНЗИСТОРОВ.

Складские условия: температура окружающей среды от +5°C до + 35°C, влажность до 85%, отсутствие в воздухе кислотных и других агрессивных примесей.

Полевые условия: Температура окружающей среды от - 50°C до + 50°C, относительная влажность до 98% при температуре + 30°C.

4. ГАРАНТИИ

Предприятие -изготовитель гарантирует срок службы транзисторов в режимах и условиях, допускаемых ОГУ и ЧТУ в течение 10.000ч. Сохраняемость транзисторов в упаковке поставщика, в ЗИПе, а также смонтированных в аппаратуру, при хранении их в складских условиях должна быть не менее 12 лет.

На протяжении этого срока допускается хранение приборов в полевых условиях в течение:

- 3-х лет в составе аппаратуры и ЗИП при защите последних от непосредственного воздействия солнечной радиации и атмосферных осадков;
- 6-ти лет в составе герметизированной аппаратуры и ЗИП в герметизированной упаковке.

Гарантийный срок исчисляется с момента отгрузки приборов.

5. УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. При эксплуатации транзистор с помощью накидного фланца должен быть жестко закреплен на металлическом шасси или на специальном теплоотводе со шлифованной поверхностью.

Перед креплением транзистора контактирующие поверхности рекомендуется смазывать невысыхающим маслом.

Диаметр отверстия в теплоотводе под выводы транзистора должен быть не более 5 мм.

2. При необходимости электрической изоляции корпуса (коллектора) транзистора от шасси или теплоотвода между транзистором и теплоотводом рекомендуется прокладка шайб из оксидированного алюминия или слюды. Суммарное тепловое сопротивление между переходом и теплоотводом увеличивается на $0,5^{\circ}\text{C} / \text{вт}$ на каждые 50 микрон слюдяной прокладки или $0,25^{\circ}\text{C} / \text{вт}$ на каждые 50 микрон слоя окиси алюминия.

3. Пайка к выводам транзистора допускается только на плоской части вывода. При пайке цилиндрическая часть вывода должна быть заката теплопроводящими губками.

Изгиб выводов допускается только на плоской части вывода.

4. Запрещается использовать транзисторы в схемах, в которых цепь базы разомкнута по постоянному току. При включении транзистора в схему базовый вывод должен присоединяться первым.

5. При монтаже транзисторов необходимо обеспечивать, чтобы фланец не ложился на сварочный шов.

6. При несоблюдении любого из предельно-допустимых параметров надежность транзистора не гарантируется.

ШТАМП
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
ЗАКАЗЧИКА

ШТАМП ЛК 113
ОТК ОТК 395

6. Р Е К Л А М А Ц И И.

В случае преждевременного выхода транзистора из строя данный прибор вернуть предприятию-изготовителю с указанием следующих данных:

Время хранения _____

Общее число часов работы транзистора _____

Основные данные режима эксплуатации _____

Причины снятия транзистора с эксплуатации или хранения _____

Сведения заполнил _____

Внимание !

По окончании эксплуатации транзистора (если прибор снят с эксплуатации после истечения срока гарантийной наработки) просим сообщить указанные выше сведения предприятию-изготовителю.